

Comunicado de prensa

La nueva tecnología de memoria flash 3D de KIOXIA y SanDisk alcanza la mayor densidad de bits del sector para la memoria NAND QLC

La memoria flash 3D QLC de 10.^a generación supone un gran avance para las arquitecturas de almacenamiento de IA, las plataformas en la nube y las innovaciones que requieren un gran volumen de datos

Alemania, Düsseldorf, 12 de agosto de 2026 – KIOXIA Europe GmbH, ha anunciado que KIOXIA Corporation, una filial de KIOXIA Holdings Corporation (TOKIO: 285A) y Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) han presentado su tecnología de memoria flash 3D Quad-Level-Cell (QLC) de última generación, que ofrece un aumento de hasta el 60 % en la densidad de bits en comparación con su 8.^a generación, superando los 37 Gb/mm² y estableciendo el referente del sector^[1] en cuanto a densidad de bits, rendimiento y eficiencia energética.

Aprovechando la revolucionaria tecnología CMOS directamente unida a la matriz (CBA)^[2] que fabrica la lógica CMOS y la matriz de memoria en obleas separadas antes de unir las con una alineación de oblea a oblea de alta precisión, la nueva generación mejora el ancho de banda de lectura y escritura en comparación con la memoria flash 3D de 8.^a generación y se convierte en la primera tecnología de memoria flash 3D QLC del sector en alcanzar los 4,8 Gb/s ^[3].

Otras mejoras en la interfaz aumentan la eficiencia energética de la transferencia de datos de salida de E/S. Estas importantes mejoras en la eficiencia energética abordan directamente los retos de alimentación y refrigeración de las infraestructuras modernas de IA y en la nube.

“A medida que la IA se va integrando cada vez más en la sociedad, sus aplicaciones están evolucionando más allá de la IA generativa hacia sistemas agentivos y físicos, lo que genera nuevas exigencias en cuanto al almacenamiento y la gestión de los datos,” afirmó Axel Störmann, vicepresidente y director tecnológico de KIOXIA Europe GmbH. “La memoria flash 3D QLC de 10.^a generación de KIOXIA desempeñará un papel importante a la hora de hacer frente al rápido crecimiento de los datos, ya que permitirá una mayor eficiencia de almacenamiento, capacidad y escalabilidad para la infraestructura de IA de próxima generación”.

El director de tecnología de SanDisk, Alper Ilkbahar, señaló: "A medida que el entrenamiento de la IA, la inferencia y las cargas de trabajo de los centros de datos a hiperescala impulsan un crecimiento sin precedentes en la generación de datos, el sector del almacenamiento se enfrenta a una presión cada vez mayor para ofrecer mayor capacidad, mejor rendimiento y una mayor eficiencia energética. Al redefinir los límites de rendimiento y eficiencia de la NAND QLC, nuestra memoria flash 3D QLC de 10.^a generación ofrece mejoras simultáneas en densidad, ancho de banda y eficiencia energética, y establece un nuevo paradigma para el almacenamiento flash de alta capacidad con el fin de proporcionar una base escalable para las aplicaciones de infraestructura de próxima generación".

Entre las características más destacadas de la tecnología de memoria flash 3D QLC de 10.^a generación se incluyen:

- La arquitectura de 332 capas y el diseño optimizado del espacio ofrecen hasta un aumento del 60 % en la densidad de bits, alcanzando >37 Gb/mm² en comparación con la 8.^a generación.
- Interfaz NAND de 4,8 Gb/s^[3] gracias a Toggle DDR6.0 y al protocolo Separate Command Address (SCA), que permite aprovechar todo el potencial de una interfaz rápida.
- La arquitectura CMOS directamente unida a la matriz (CBA) mejora la escalabilidad de la densidad, el rendimiento y la eficiencia de fabricación.
- La terminación de baja potencia con toma aislada (PI-LTT) mejora la eficiencia energética en la transferencia de datos de salida de E/S.

###

Notas:

1. A fecha de 4 de agosto de 2026, según una encuesta de KIOXIA y Sandisk.
2. Tecnología en la que las obleas CMOS y las obleas de la matriz de celdas se fabrican por separado en sus condiciones óptimas y posteriormente se unen mediante unión de obleas.
3. 1 Gb/s se calcula como 1 000 000 000 de bits por segundo. Este valor se ha obtenido en nuestro entorno de pruebas específico y puede variar según las condiciones de uso.

Los nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas comerciales de terceros.



Acerca de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH es la filial europea de KIOXIA Corporation, un proveedor líder mundial de memorias flash y unidades de memoria de estado sólido (SSD). Desde la invención de la memoria flash NAND hasta la popular memoria flash 3D BiCS FLASH™, KIOXIA sigue siendo pionera en soluciones y servicios de memoria de vanguardia que enriquecen la vida de las personas y amplían los horizontes de la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D BiCS FLASH™ de la empresa está moldeando el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los smartphones avanzados, ordenadores de sobremesa, los sistemas automotrices, los centros de datos y los sistemas de IA generativa.

Visite nuestro [sitio web de KIOXIA](#)

Datos de contacto para la publicación:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Alemania

Tel.: +49 (0)211 368 77-0

Correo electrónico: KIE-support@eu.kioxia.com

Datos de contacto para consultas editoriales:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel.: +49 (0) 211 36877 382

Correo electrónico: lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Publicado por:

Birgit Schöninger, Pretzl GmbH

Tel.: +49 (0)172 617 8431

Correo electrónico: birgit.schoeniger@pretzl.com

Web: www.pretzl.com